

عنوان مقاله:

طراحی و بررسی عملکرد یک تقویت کننده CMOS دو طبقه 1.8V ، 0.18 μ m با افت توان پایین

محل انتشار:

اولین همایش متخصصین برق و کامپیوتر (سال: 1389)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسنده:

پیمان کرمی - دانشگاه جامع علمی کاربردی مینو- خرم دره

خلاصه مقاله:

این مقاله به معرفی نتایج یک پژوهش در مورد طراحی و شبیه سازی یک تقویت کننده CMOS دو طبقه با استفاده از تکنولوژی 0.18 μ m می پردازد. در طراحی تقویت کننده های عملیاتی دو طبقه در صورتی که از روش جبران سازی میلری استفاده شود مدار پایدارتر خواهد شد. بهره DC این تقویت کننده بالا و مقدار THD آن پایین می باشد. افت توان در این مدار پایین و جریان بایاس آن کوچک می باشد. این مدار سوئیچینگ ولتاژی در حدود 1Vp-p داشته و ابعاد آن در صورت استفاده از تکنولوژی 0.18 μ m کوچک خواهد بود. در نتیجه این تقویت کننده برای استفاده در سیستم های الکترونیکی و مخابراتی مناسب می باشد

کلمات کلیدی:

بهره ، تفاضلی ، دو طبقه، CMOS ، 0.18 μ m

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/97684>

